

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 27 年 4 月 16 日 (2015.4.16)

【公開番号】特開 2013-182942 (P2013-182942A)

【公開日】平成 25 年 9 月 12 日 (2013.9.12)

【年通号数】公開・登録公報 2013-049

【出願番号】特願 2012-44300 (P2012-44300)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 1 4 A

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 3 月 2 日 (2015.3.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

境界線で互いに接する第 1 領域および第 2 領域を有する半導体装置の製造方法であって

、

前記境界線に平行で前記第 1 領域の中に配置された第 1 線と前記境界線に平行で前記第 2 領域の中に配置された第 2 線とで幅が規定された境界線上ライン部を含むパターンを形成するフォトリソグラフィ工程を含み、前記フォトリソグラフィ工程は、

基板に塗布されたフォトレジストに対して、前記第 1 線を規定するための第 1 露光および前記第 2 線を規定するための第 2 露光を別個に実施する露光工程と、

前記露光工程を経た前記フォトレジストを現像する工程と、を含む、

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

前記第 1 露光において、前記第 1 領域の中に前記境界線上ライン部に平行な複数の第 1 ライン部を規定するように前記フォトレジストを露光し、

前記第 2 露光において、前記第 2 領域の中に前記境界線上ライン部に平行な複数の第 2 ライン部を規定するように前記フォトレジストを露光する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

前記複数の第 1 ライン部における隣り合う第 1 ライン部の間隔、前記複数の第 1 ライン部のうち前記境界線上ライン部に最も近い第 1 ライン部と前記境界線上ライン部との間隔、前記複数の第 2 ライン部における隣り合う第 2 ライン部の間隔、および、前記複数の第 2 ライン部のうち前記境界線上ライン部に最も近い第 2 ライン部と前記境界線上ライン部との間隔が、互いに等しい、

ことを特徴とする請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

前記境界線は、所定方向に沿った直線に平行な複数の直線部と、前記複数の直線部を連結する連結部とを含み、

前記半導体装置は、複数の前記境界線上ライン部を有し、前記複数の直線部のそれぞれに対して 1 つの前記境界線上ライン部が設けられている、

ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

**【請求項 5】**

前記フォトレジストは、ポジ型フォトレジストである、  
ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

**【請求項 6】**

前記フォトレジストは、ネガ型フォトレジストである、  
ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。